

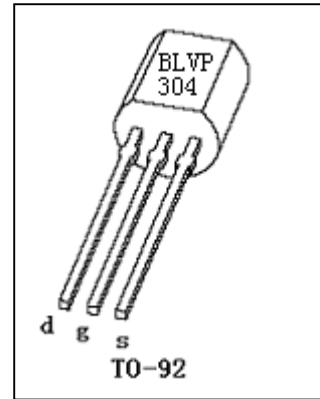
P 沟纵向 MOSFET

描述:

P 沟增强型 VDMOS, 高速开关, 无二次击穿

产品应用:

- 电话机电路
- 继电器电路
- 驱动电路等



工作条件 (T=25°C)

符号	参数	极限值	单位
V_{DSS}	漏源电压	-300	V
V_{GSS}	栅源电压	± 20	V
I_D	漏电流	-170	mA
P_D	Power Dissipation for Dual Operation	1	W
T_j, T_{SDG}	结温度和存储温度	-55 to +150	°C

热特性

$R_{th\ j-a}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	125	K/W
---------------	---	-----	------------

电学特性 (T_A=25°C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
BV_{DSS}	源漏击穿电压	$V_{GS} = 0V, I_D = -10\mu A$	-300	-	-	V
I_{DSS}	零栅压时的漏极电流	$V_{DS} = -240V, V_{GS} = 0V$	-	-	-100	nA
I_{GSS}	栅和衬底之间的漏电流	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	-	-	± 100	nA
$V_{GS(th)}$	阈值电压	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -1mA$	-1.7	-	-2.55	V
$R_{DS(on)}$	导通电阻	$V_{GS} = -10V, I_D = -170mA$	-	-	18	Ω

交流特性

Ciss	输入电容	V _{DS} =-25V, V _{GS} =0V F= 1MHz	-	60	90	pF
Coss	输出电容		-	15	30	pF
Crss	反馈电容		-	5	15	pF

开关特性

t _{on}	Turn-On 时间	V _{DD} =-50V, I _D =-250mA	-	5	10	nS
t _{off}	Turn-Off 时间	V _{GS} =0 to -10V	-	15	30	ns